

Усовершенствованная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Растровая электронная микроскопия полупроводниковых материалов и структур», разработанная в рамках выполнения ОКР «Разработка универсального растрового электронного микроскопа»

27.02.2026 г. - 15.05.2026 г., Московская обл., г. Черноголовка, ИПТМ РАН

Лекторы

Главный научный сотрудник лаборатории №14, д.ф.-м.н. Якимов Е.Б.
Заведующий лабораторией №15, к.ф.-м.н. Казьмирук В.В.

Темы лекций

1. Растровый электронный микроскоп. Казьмирук В.В.
2. Взаимодействие ускоренных электронов с твердым телом. Якимов Е.Б.
3. Режимы вторичных и обратно отраженных электронов. Якимов Е.Б.
4. Метод наведенного тока (EBIC). Якимов Е.Б.
5. Метод катодolumинесценции. Якимов Е.Б.
6. Рентгеновский микроанализ. Якимов Е.Б.
7. Дифракция обратно отраженных электронов (EBSD) Каналирование. Якимов Е.Б.
8. Влияние электронного пучка РЭМ на свойства материалов. Якимов Е.Б.
9. Формирование и применение вторично эмиссионных сигналов в РЭМ. Казьмирук В.В.
10. Специализированные электронно-лучевые системы для микроэлектроники. Казьмирук В.В.